



**ALLEGATO C: RIEPILOGO VALORI TECNICI**

**LINEA PER ASSOTTIGLIAMENTO IN SILICIO**

Il presente documento riassume le specifiche dell’apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle, mediante indicazione dei valori offerti e il riferimento al relativo paragrafo della relazione tecnica.

(Riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell’Offerente)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rif. paragrafo capitolato** | **Strumento o tipologia di processo** | **Criterio di valutazione** | **Valore offerto** | **Rif. paragrafo**  **offerta tecnica** |
| 1.1 | Generiche per il cluster di strumenti | Footprint totale, compresa area di servizio/manutenzione < 25 m2 |  |  |
| 1.2 | Anno di garanzia aggiuntivo |  |  |
| 2.1 | Edge trimmer | Strumento nuovo |  |  |
| 2.2 | Risoluzione spostamento in ϑ del chuck table < 0.1” |  |  |
| 2.3 | Parallelismo faccia superiore chuck table a 22°C < 0.010 mm / 150 mm |  |  |
| 2.4 | Accuratezza posizionamento sul piano di taglio (x o y) < 0.004 mm/260 mm |  |  |
| 2.5 | Ripetibilità dello spostamento in z < ±0.003 mm |  |  |
| 3.1 | Grinder | Strumento nuovo |  |  |
| 3.2 | Presenza doppio height gauge in linea per misura simultanea dell’altezza wafer e chuck table durante le operazioni di grinding o alternativamente presenza di sistema di misura ottico non a contatto |  |  |
| 3.3 | Risoluzione sistema height gauge < 0.2 µm |  |  |
| 3.4 | Velocità avanzamento minimo del mandrino/mola lungo z < 0.0002 mm/s |  |  |
| 3.5 | Risoluzione dello spostamento in z < 0.2 µm |  |  |
| 4.1 | Strumento di cleaning | Strumento nuovo |  |  |
| 5.1 | Processo #A1 – Ultrathinning | Resa di processo (percentuale di wafers che rispettano tutti i requisiti minimi e migliorativi dichiarati nello specifico processo) > 60% |  |  |
| 5.2 | TTV finale complessivo dello stack < 5 µm |  |  |
| 5.3 | Rugosità superficiale (Ry) wafer di processo post grinding < 0.5 µm |  |  |
| 5.4 | Throughput del processo di grinding > 1 wafers/ora |  |  |
| 5.5 | Accuracy to target sullo spessore del wafer di processo post grinding < ±3 µm |  |  |
| 6.1 | Processo #A2 – Thinning a 250 µm | Resa di processo > 90% |  |  |
| 6.2 | TTV finale wafer di processo post grinding < 2 µm |  |  |
| 6.3 | Rugosità superficiale (Ry) wafer di processo post grinding < 0.2 µm |  |  |
| 6.4 | Throughput del processo di grinding > 5 wafers/ora |  |  |
| 6.5 | Accuracy to target sullo spessore del wafer di processo post grinding < ±3 µm |  |  |
| 6.6 | Depth of damage sul wafer di processo post grinding < 2 µm |  |  |
| 7.1 | Processo #A3 – Thinning a 150 µm | Resa di processo > 80% |  |  |
| 7.2 | TTV finale wafer di processo post grinding < 6 µm |  |  |
| 7.3 | Rugosità superficiale (Ry) wafer di processo post grinding < 0.2 µm |  |  |
| 7.4 | Throughput del processo di grinding > 3 wafers/ora |  |  |
| 7.5 | Accuracy to target sullo spessore del wafer di processo post grinding < ±10 µm |  |  |